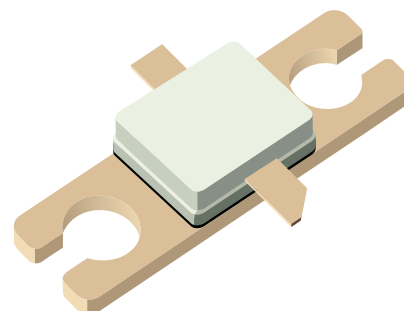


Мощный СВЧ GaN транзистор с напряжением питания 28 В
 Герметизирован в металлокерамическом корпусе КТ-81С
 Предназначен для работы в усилителях мощности до 6000 МГц

- Выходная мощность $P_{\text{вых}} = 25$ Вт
- Напряжение питания $U_{\text{си}} = 28$ В
- Коэффициент усиления по мощности $K_{\text{ур}} \geq 9,0$ дБ
- КПД стока $\eta_c \geq 50$ %



Предельно допустимые значения электрических режимов эксплуатации

Максимально допустимый постоянный ток стока	I_c макс	3,0	А
Максимально допустимый прямой ток затвора	I_z (пр) макс	10,0	мА
Максимально допустимое постоянное напряжение сток-исток	$U_{\text{си макс}}$	120*	В
Напряжение затвор-исток	$U_{\text{зи}}$	-10 до +2	В
Максимально допустимая температура перехода	$t_{\text{п макс}}$	225	°С
Диапазон рабочих температур		-60 до +125	°С
Тепловое сопротивление переход-корпус транзистора	$R_{\text{т п-к}}$	**	°С/Вт

* При температуре корпуса 25°С

** Уточняется в ходе проведения испытаний

Электрические параметры транзисторов

Параметр	Обозначение	Режим измерения	Не менее	Тип.	Не более	Единица измерения	Температура среды (корпуса), °С
Остаточный ток стока	I_c ост	$U_{\text{си}}=80$ В; $U_{\text{зи}}=-8$ В	-	-	3,0	мА	25±10
Крутизна характеристики	S	$U_{\text{си}}=10$ В; $I_c=2,5$ А	2,6	3,0	-	А/В	25±10
Ток стока насыщения	I_c нас	$U_{\text{си}}=6$ В; $U_{\text{зи}}=2$ В	10,6	11,0	-	А	25±10
Выходная мощность	$P_{\text{вых}}$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В $P_{\text{вых}}=2,8$ Вт $I_c=0,2$ А	25	30	-	Вт	(25±15)
Коэффициент усиления по мощности	$K_{\text{ур}}$	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=25$ Вт $I_c=0,2$ А	9,0	11,0	-	дБ	(25±15)
КПД стока	η_c	$f=4000$ МГц; $U_{\text{си}}=28$ В; $P_{\text{вых}}=25$ Вт; $I_c=0,2$ А	50	52	-	%	(25±15)

Габаритный чертеж

